



## 肖特基桥式整流器 Schottky Bridge Rectifier

## ■ 特征 Features

- $I_o$  1.0A
- $V_{RRM}$  20V~100V
- 肖特基芯片  
Schottky chip
- 耐正向浪涌电流能力高  
High surge forward current capability
- 低正向电压  
Low VF

## ■ 用途 Applications

- 作一般电源单相桥式整流用  
General purpose 1 phase Bridge rectifier applications

## ■ 极限值（绝对最大额定值）

## Limiting Values (Absolute Maximum Rating)

参数名称 Item	符号 Symbol	单位 Unit	条件 Conditions	MBSK				
				12M	14M	16M	18M	110M
反向重复峰值电压 Repetitive Peak Reverse Voltage	$V_{RRM}$	V		20	40	60	80	100
平均整流输出电流 Average Rectified Output Current	$I_o$	A	60Hz正弦波, 电阻负载, $T_a=25^\circ C$ 60Hz sine wave, R-load, $T_a=25^\circ C$				1.0	
正向(不重复)浪涌电流 Surge(Non-repetitive)Forward Current	$I_{FSM}$	A	60Hz正弦波, 一个周期, $T_j=25^\circ C$ 60Hz sine wave, 1 cycle, $T_j=25^\circ C$				40	
正向浪涌电流的平方对电流浪涌持续时间的积分值 Current Squared Time	$I^2t$	$A^2S$	$1ms \leq t < 8.3ms$ $T_j=25^\circ C$ , 单个二极管 $1ms \leq t < 8.3ms$ $T_j=25^\circ C$ , Rating of per diode				6.6	
存储温度 Storage Temperature	$T_{stg}$	°C					-55 ~ +150	
结温 Junction Temperature	$T_j$	°C					-55 ~ +150	

■ 电特性 ( $T_a=25^\circ C$  除非另有规定)Electrical Characteristics ( $T_a=25^\circ C$  Unless otherwise specified)

参数名称 Item	符号 Symbol	单位 Unit	测试条件 Test Condition	最大值 Max		
正向峰值电压 Peak Forward Voltage	$V_{FM}$	V	$I_{FM}=0.5A$ , 脉冲测试, 单个二极管的额定值 $I_{FM}=0.5A$ , Pulse measurement, Rating of per diode	0.55	0.65	0.85
反向峰值电流 Peak Reverse Current	$I_{RRM}$	mA	$V_{RM}=V_{RRM}$ , 脉冲测试, 单个二极管的额定值 $V_{RM}=V_{RRM}$ , Pulse measurement, Rating of per diode			0.5
热阻 Thermal Resistance	$R_{\theta J-A}$	°C/W	结和环境之间, 安装在玻璃-环氧基板上 Between junction and ambient, On glass-epoxy substrate			134
	$R_{\theta J-L}$		结和引线之间 Between junction and lead			20



## ■特性曲线（典型） Characteristics(Typical)

图1: Io-Ta曲线  
FIG1:Io-Ta Curve

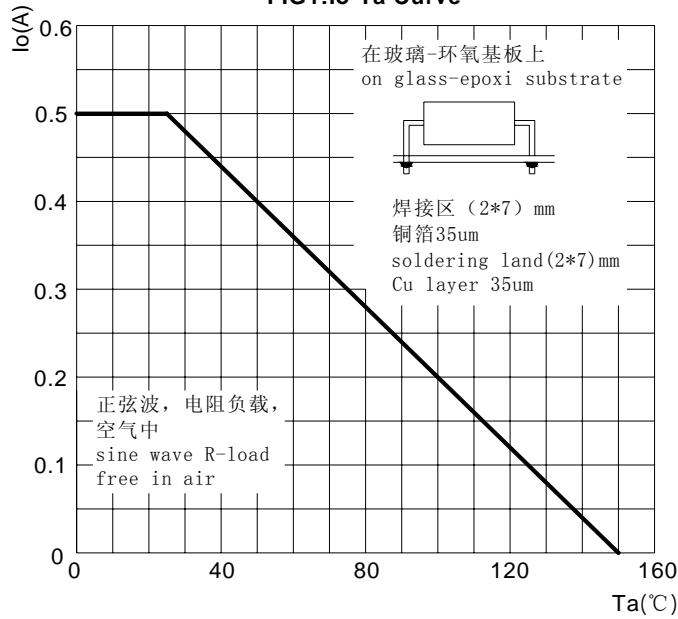


图2: 耐正向浪涌电流曲线  
FIG2:Surge Forward Current Capability

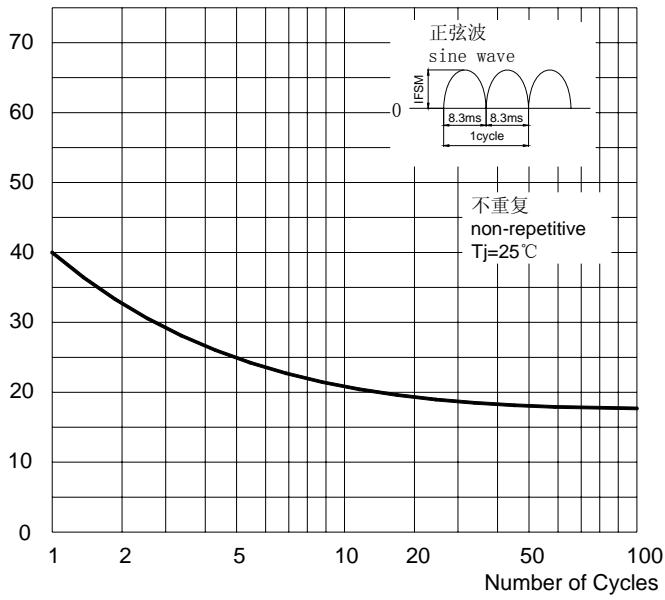


图3: 正向电压曲线  
FIG3: Forward Voltage

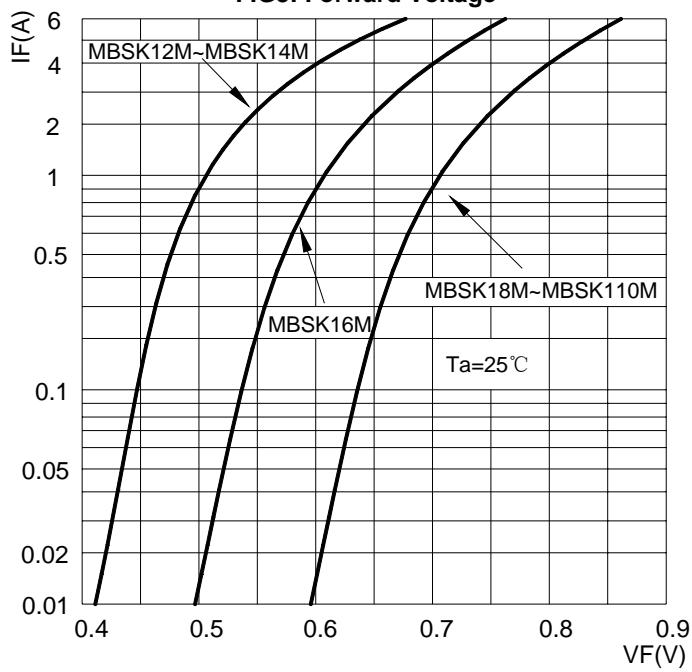


图4: 反向电流曲线  
FIG4:Typical Reverse Characteristics

